鉄90°磁壁,ニッケル109°および71°磁壁の安定方位に 関する理論とX線トポグラフィによる実測

(昭和54年5月31日 前稿受付)

物理学教室 近 浦 吉 則

Stable Orientations of 90° Walls in Iron, and 109° Walls and 71° Walls in Nickel — Theory and X-Ray Observations

by Yoshinori CHIKAURA

Abstract

The modified domain theory, which has been developed in the previous paper with a help of quasi-dislocation theory, has been applied to investigate the energitically stable orientations of 90' walls in iron and 109' walls in nickel. The theoretical results are compared with the wall orientations determined experimentally from X-ray topographic images of 90' walls in iron whiskers and 109' walls in nickel plate crystals. Agreement between the theory and the experiment is satisfactory. Orientation of 71 walls in nickel is also discussed.

§1. 緒 論

Néel 則¹¹を満たす磁壁の安定方位を理論的に知るた めに、従来の磁区構造論では考慮されなかったエネル ギーを導入し、これを前報²¹において磁壁の実効エネル ギーと名づけた。本論文の主たる目的は前報に述べられ た考え方(方法論)を鉄の90磁壁、ニッケルの109³磁壁 および71⁴磁壁に適用し、それらの安定方位を求め、その 結果とX線トポグラフィによる観察結果とを比較するこ とである。まず次節 §2において鉄90⁵磁壁についての 計算および観察結果について述べ、§3では、ニッケル 0109³磁壁および71⁶磁壁の坞合に言及する。

鉄の場合,ニッケルの場合ともに理論と実験結果との よい一致が得られた。これは前報²¹および本論文で述べ ^{られた考え方の健全性を示すものである。}

§2. 鉄の90 磁壁

2.1. 鉄90 磁壁の実効エネルギーと安定方位

図-1のように板状の90^{*}磁区(1)が充分大きなマト ^{リックス磁区(L,R)の中に形づくられている磁区構造を ^{考える}。2枚の90磁壁ABCDおよびA'B'C'D'は距} 離 2 a だけ離れ、3 つの磁区L、1, Rをつくっている。 マトリックス磁区 L, Rと磁区 1 の磁化ベクトル M お よび M₁ はそれぞれ($\overline{100}$)、(010)に平行である。結晶表 面における磁壁の線AB, A'B'は Néel 則"によって (110) 方向にあり、結晶内部の磁壁は(100)面から角度 Ψ だけ傾いている。表面におけるABとA'B'との間隔 を 2 d とすれば

 $2d = 2a/\sin\Psi$



図一1 90°磁壁の方位に依存する磁気弾性相互 作用を計算するための磁区構造モデル である。直交座標系 x_i を, x₁ // (100), x₂ // (010), x₃ // (001)とし, 原点は磁区 I の中央の位置, と定める と,磁歪テンソルは x_i 系で

$$\begin{vmatrix} 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{\lambda}{2} \end{vmatrix} : \overrightarrow{\mathbb{K}} \boxtimes I$$
 (3)

λ; 自発磁化(100)方向の磁歪(=2.1×10⁻³) 故にマトリックス磁区L, Rの磁歪を基準にすると、磁 区1には

$$\{\beta_{ij}^{*}\} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}\lambda & 0 & 0\\ 0 & \frac{3}{2}\lambda & 0\\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
(4)

で表わされる塑性歪が存在する。ここで以降の計算を簡 単にするため新しい座標系 X_i (X_i は磁壁面に垂直に, X_2 ば110)に平行に、そして X_3 は(110)表面の磁壁線に 平行にとる)を導入する。上式(4)を X_i 系に変換すると、

$$\left(\beta_{ij}^{\star}\right) = \frac{3}{2}\lambda \begin{pmatrix} 0 & -\sin \Psi & 0\\ -\sin \Psi & 0 & \cos \Psi\\ 0 & \cos \Psi & 0 \end{pmatrix} \\
\cdot \left\{H(X_1 + a) - H(X_1 - a)\right\}$$
(5)

H(X); ヘビサイドの段階関数,

X > 0 のとき H(X) = 1, X < 0 のときH(X) = 0。

上式と前報²1式000より90 磁壁に等価な擬転位密度テン ソル (a_h) は、

$$(\alpha_{hj}) = \frac{3}{2} \lambda \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \Psi & 0 \\ \sin \Psi & 0 & -\cos \Psi \end{pmatrix} \cdot \{ \delta(X_1 + a) - \delta(X_1 - a) \}$$
(6)

 $\delta(X)$; ディクックのデルタ関数. 式(6)を図に表わしたのが図-2である。 a_{31} は X_3 方向の刃 状転位、 a_{32} および a_{33} はそれぞれ X_2 および X_3 方向の らせん転位に対応する。ここで注意すべきことはこれら 3種の擬転位が 2 枚の磁壁面全体にわたってなめらかに



図-2 90°磁壁に等価な擬転位の運続分布・b; バーガースベクトル:転位線ベクトル

連続的に分布していることである。この連続的擬転位分 布は結晶内に応力場をつくる。 a31 による効果は小傾角 粒界にみられるように、単に両磁区を相対的に回転させ るだけで何らの応力場もつくらない。 a22 および a31 の 組による応力場は前報²¹式22より容易に計算できて

$$(\sigma_{ij}) = 3\lambda\mu \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\cos\Psi \\ 0 & -\cos\Psi & 0 \end{pmatrix} \cdot \{H(X_1 + a) - H(X_1 - a)\}$$

(7)

μ; 剛性率 (=8.2×10¹¹[dyn/cm²])

がえられる。

この結果,弾性的な歪場は磁区 I にのみ存在していることがわかる。磁区 I に貯えられる弾性エネルギーは単位体積当り,

$$\begin{split} \varphi_{ci} &= -\frac{1}{2V} \iint_{V} \sum_{j} \sum_{j} \sigma_{ij} \beta_{ij}^{*} \mathrm{d}x_{1} \mathrm{d}x_{2} \mathrm{d}x_{3} \\ &= \frac{9}{2} \mu \lambda^{2} \cos^{2} \Psi \end{split}$$
 (8)

Ⅴ; 磁区Ⅰの体積

$$(e_{ij}) = \frac{3}{2}\lambda\cos\psi \begin{pmatrix} \cos\psi & 0 & -\sqrt{2}\sin\psi \\ 0 & -\cos\psi & -\sqrt{2}\sin\psi \\ -\sqrt{2}\sin\psi & -\sqrt{2}\sin\psi & 0 \end{pmatrix}$$
; $\overrightarrow{\mathbf{W}}\overrightarrow{\mathbf{Z}}$ I (9)

220

$$\phi_{me} = -B_1 \frac{3}{2} \lambda \cos^2 \Psi \tag{10}$$

等方的弾性体では

$$C_{11} - C_{12} = 2C_{14} = 2\mu$$

が成り立つから、前報(2)式(13)より

$$B_1 = -3\mu\lambda \tag{11}$$

故に

$$\Phi_{\rm me} = \frac{9}{2}\mu\lambda^2\cos^2\Psi \tag{12}$$

従って磁区エネルギー Øa は磁区 I の単位体積当り、

$$\Phi_{\rm d} = \Phi_{\rm cl} + \Phi_{\rm me} = 9\mu\lambda^2 \cos^2 \Psi \tag{13}$$

となる。

結晶のもつ全エネルギーは,単位面積の磁壁に垂直で間 冪2 a の磁区 I を考えると,

 $(2\phi_w + 2a \cdot \phi_d)$



図-3 磁型エネルギー ϕ_{α} および磁区エネル ギー $2a \cdot \phi_a/2$ の磁盤方位依存

$$\begin{aligned} \Phi_{etf} &= \Phi_{w} + a \Phi_{d} \\ &= \Phi_{w} + 9 a_{f} \lambda^{2} \cos^{2} \Psi \end{aligned} \tag{14}$$

図-3に、Spacek³⁾による \mathfrak{O}_* の数値計算結果と磁区エネ ルギーの寄与 $a\mathfrak{O}_a$ を磁壁方位 Ψ の関数として示す。磁 区間隔 2aが数+ (μm) 以上になると、磁区エネルギー は Ψ のほとんど全範囲にわたって \mathfrak{O}_* より大きくなるこ とがわかる。

 $X_2 = X_3$ 面の単位面積当りの実効エネルギー ϕ_{err} は幾何 学因子を考慮することによって、(1)および(ゆより、

$$\begin{aligned} \Phi_{ctt}' &= \Phi_{ctt} / \sin \Psi \\ &= \Phi_w / \sin \Psi + 9 d\mu \lambda^2 \cos^2 \Psi \end{aligned}$$
 (5)

2d; 結晶表面における磁区の間隔

がえられる。

図-4に ϕ'_{err} を方位 ψ の関数としてえがいている。この ϕ'_{err} の極小条件

$$\partial \Phi_{\rm eff}^{\prime} / \partial \Psi = 0 \tag{16}$$



 図一4 幾何学因子を考慮した実効エネルギー
 の症(の種々の2d の値に対する磁盤方 位との関係

222



 図-5 90°磁壁の安定方位Ψ*と磁区の大きさ 2dとの関係曲線(実線), ○:鉄ウィス カーのX線トポグラフ観察より求めた 実測値, ● DeBlois らが表面磁区図形 から推定した値

から磁壁の安定方位 Ψ *が決まる。磁壁エネルギー σ_w が 解析的には求められないので、(0)を満たす安定方位 Ψ *を 数値計算からえたのが図-5である。

安定方位 Ψ^{\bullet} は 2 d = 0の時62° すなわちほぼ {111} 面か ら、2 dの値と共に急に増大し 90° ({110} 面) に漸近す ることがわかる。例えば、磁区の大きさが100 (μ m) ぐ らいでは $\Psi^{\bullet} \sim 90°$ で、磁壁は {110} 面にほとんど平行にな ることが知られる。従来の磁区構造論の結論である鉄 90° 磁壁の安定方位がほぼ {111} 面にあるというのは、本 理論において

2 d = 0

の特別な場合になっている。これはいうまでもなく、磁 区エネルギー **の**。の見落しによって生じた結果である。

2.2. X線トポグラフィによる実験結果との比較

軸方位<100>,表面方位{100}の鉄ウィスカーには無転 位で90⁶磁壁を含むものがあること、そしてその90⁶磁壁 はX線トポグラフィによって何らの機械的拘束を試料に 与えず観察できることを著者ら⁴⁵⁵は報告している。従っ て、鉄ウィスカーに見られる矩形磁区のX線トポグラフ 観察は、磁壁方位に関する理論の健全性を実証するのに 理想に近い。

図-6 (a) は短形磁区の011トポグラフ (MoK a_1) で 同図 (b) にその空間的形状を図示している。磁壁の安定 方位 Ψ^{\bullet} は結晶側面における短形磁区の傾き角 ϕ と次の 関係がある。



図-6-(a) 鉄ウィスカーの矩形磁区の011 トポグラフ,スケールマークは 100[µm],gは反射ベクトル





$$\cos \Psi^* = \frac{1}{\sqrt{2}} \cos \phi \qquad (1)$$

この角度 ϕ は 0 1 1 トポグラフ上に角度 η として記録 される。簡単な幾何学的考察によって,

$$\tan\phi = \tan\eta \left/ \cos\left(\frac{\pi}{4} - \theta_{\rm B}\right) \tag{1}$$

をうる。一方(100)表面の短形磁区幅2dはトポグラフ上のWと

$$2d = W/\sqrt{2}$$
⁽¹⁹⁾

の関係がある。

式(I7)~(19)によって Ψ^{\bullet} と 2 d の関係が、0 1 $\overline{1}$ トポクラ フの η および W の測定から得られる。その結果を図-5 に〇印で示し、理論曲線と比較している。測角の精度は 約±2°である。図-5には DeBloisら⁶⁰の粉末図形法によ って推定した結果を●印で示した。理論と実験結果との 一致はかなりよいことがわかる。

2.3. 磁区 I の単位格子

格子歪が磁区 I の内部で一定であるということは磁区 内の単位格子が変化しているということである。主軸座 振系 xi での格子変位を考えることによって、矩形磁区内 の単位格子のパラメーターは次のように、表わされる。

$$a = a_0 \left\{ 1 - \frac{3}{2} \lambda (1 - 3\cos^2 \Psi) \right\}$$

$$b = a_0 \left\{ 1 + \lambda \left(1 - \frac{3}{2} \cos^2 \Psi \right) \right\}$$

$$c = a_0 \left(1 - \frac{\lambda}{2} \right)$$

$$\cos \alpha = \cos \beta = -\frac{3}{2} \lambda \cdot \sin \Psi \cdot \cos \Psi$$

$$\cos \gamma = 0$$

磁化ベクトル $M_1 / (010)$ この計算で λ^2 以上の高次の項を無視した。c軸は(001)から $(\overline{1}\overline{1}0)$ 方向へ $\frac{3}{2}\lambda \sin \Psi$ だけ傾き, a軸とb軸 は(001)面内でそれぞれ (100), (010)方向へ $\frac{3}{2}\lambda \sqrt{2}\cos^2 \Psi$ だけ傾いている。この単位格子を図-7に 図示する。晶系は三斜晶系,点群は $\overline{1}$ となる。



図-7 磁区1の単位格子、三斜晶系となる。

§3. ニッケルの109 磁壁および71 磁壁

 3.1. |100| で囲まれたニッケル無転位結晶の X線トポグラフとその磁区構造

著者ら¹¹⁸¹は水素-窒素混合ガスによる臭化ニッケル の還元によって種々の形態のニッケル結晶がえられるこ とを報告した。育成条件を適切に制御すると {100} 面で囲まれた板状ニッケル単結晶をえることができる。 X線トポグラフ観察の結果,これらの単結晶は無転位で ある。

図-8 (a), (b) は厚さ90 [µm], 幅350 [µm]の板状 ^{ニッケル}結晶の220および11 「トポグラフである。 結晶内部の主要な磁区(以下主磁区と称する)は結晶表





図-9 111 トポグラフ記録の幾何学的配置

direction of the

reflected beam

(21)

面上において軸と45の方向すなわち〈110〉方向をな し、コントラストは71°または109°磁壁によるものである。主 磁区の間隔は約15[μm]である。ニッケルの自発磁化方向 は〈111〉であるから結晶表面には還流磁区が生ずる。 220トポグラフに見られるジグザグ状の小さな磁区が それである。ここでは結晶内部の主磁区のみ注目するこ とにしよう。主磁区の磁壁像の幅は111下トポグラフ上 で約10[μm]となっている。従って図-9の幾何学的配 置と式20より磁壁面と(11下)とのなす角は約4°であ ることがわかる。すなわち実測の誤差範囲内で磁壁面は (11下)面に平行となっている。

 $90(\mu m) \times tan(\theta_B - \delta) = 10 \ (\mu m)$

θ_B; 111反射のブラッグ角 (=10°2', MoKα₁)

δ; (111) 面からの傾き角

Nèel 則を満たす109°と71°磁壁のとりうる方位を示す



図-10 109 磁壁と71 磁壁のとりうる方位



図-11 {111} に平行な109* 磁壁でつくられる 結晶内部の磁区構造

図-10 (a), (b) から71 磁壁は必ず <100> 方向を回転 軸として含まねばならないことがわかる。このことは図 -8に観察される磁壁は,(111)面にあるので,71 磁壁 ではなく109 磁壁であることを意味している。従って結 晶内の磁区構造は図-11の模型で与えられる。

次にこのような109 磁壁の間隔 D を推定する。正負の 磁区が交互になった磁区構造の模型 (図-11) についての 静磁エネルギー E_{dem} を計算すると、前報²¹式(9)より

 $E_{\rm dem} = 1.08 \times 10^4 \, J^2 D \tag{22}$

一方, 磁壁によるエネルギー Ew は

 $E_{\rm w} = \Phi_{\rm w} \cdot L/D \tag{23}$

磁区幅Dは Edem と Ew の和

 $E = E_{dem} + E_W \tag{24}$

を種小にする様に決まる。故に,

 $\partial E/\partial D = 0$

より,

$$D = \left[\Phi_{\rm W} \cdot L / 1.08 \times 10^4 I^2 \right]^{\frac{1}{2}} \tag{25}$$

をうる。

 $\{100\} = \gamma \forall \nu \forall t I_5 = 0.61 \{Wb/m^2\}, I = I_5 \cos 35.3^\circ = 0.33 \{Wb/m^2\}, L = 9 \times 10^{-5} \{m\}, \Phi_w = 6 \times 10^{-3} \{J/m^2\}$

だから,(25)より

 $D \simeq 23 \, (\mu \mathrm{m})$

をうる。これは 111 トポグラフ上で

$$23 \times \cos \theta_{\rm B} = 21 \, [\mu {\rm m}]$$

に相当し,実測値の15 (μm)とほぼ一致している。 このことからも図-11の磁区構造模型の正当性が確めら れた。

3.2. 109 磁壁の安定方位

この磁壁は2つの磁化ベクトルの終点を結ぶ(110) を軸として回転できるから、両ベクトルのつくる [11 01 面と磁壁面とのなす角度 Ψ でその方位を表現する (図-10)。 図-12 は109 磁壁の磁区エネルギー $\phi_{e} \epsilon$ 計算するための磁区模型 である。この図で結晶表面を (110)面にとっているのは、自由磁壁の影響を考え ないためである。図-11の構造のように磁極が結晶表面 に生ずる結晶の場合でも、結晶内部の磁壁の方位を議員 する限り、磁区エネルギーの値はそのまま使える。座標 系 X_i は次のように決める。 X_i ; 磁壁面に垂直、 X_2 : [10]に平行、 X_3 ; (110)面上の磁壁線に平行、原 点; 109 磁区の中央の位置。この座標系 X_i に対する磁 区1内の塑性歪は、鉄の場合の式(5)に対応して、

$$[\beta_{ij}^{\bullet}] = -1.4182\lambda_{111} \begin{pmatrix} 0 & \sin \Psi & 0 \\ \sin \Psi & 0 & \cos \Psi \\ 0 & \cos \Psi & 0 \end{pmatrix}$$
$$\cdot \{H(X_1 + a) - H(X_1 - a)\} \emptyset$$

となるから、 振転位密度テンソル (の)は







 □-12 109^{*} 磁壁による弾性歪の計算のための 磁区構造モデル



図ー13 109、磁壁と等価な擬転位の連続分布 b;パーガースベクトル、ν;転位線ベ クトル

となる。上式を図示したのが図―13である。 この複転位分布による磁区エネルギーの4は

 $2\Phi_d' = 1.900 \times 10^3 \times (2d) \cos^2 \Psi \cdot \sin \Psi \qquad (29)$

ただし、ここで Ød は単位面積の1枚の磁壁当りの磁区 エネルギーとする。ニッケルの場合には種々の磁区構造 が考えられるから、単位体積当りの磁区エネルギー Ød を使うより便利である。

このとき、実効エネルギーは、

 $\Phi_{\rm eff}(\Psi) = \Phi_{\rm w}(\Psi) + \Phi_{\rm d}'(\Psi, 2d) \tag{30}$

のように表現される。式四の計算で用いた物性値は、

 $\lambda_{111} = -2.43 \times 10^{-5}, \ \mu = 8.0 \times 10^{11} \ [dyn/cm^2]$

である。図-14に $\phi_{4}(\Psi, 2a)$ (ただし $2a = 2d\sin\Psi$) および数値計算された ϕ_{w} を比較している。 図-12の結晶で,単位断面積の (0 0 1) 面をもつ柱状結 晶中に貯えられる実効エネルギー ϕ_{en} は,

 $\Phi_{\rm ctt}'(\Psi) = (\Phi_{\rm w} \pm \Phi_{\rm d}')/\sin \Psi$

= $\varphi_w/\sin \Psi + 9.5013 \times 10^2 \times (2d)\cos^2 \Psi$ (3) 安定方位 $\Psi \cdot \varepsilon$ 上式の極小条件より求めた結果を図-15 に示す。傾向 ($\Psi - 2d$) は鉄の90 磁壁の場合と同様であ ^{るが、}この場合 2d = 0 で $\Psi \cdot = 81$ から出発して徐々に 90 に漸近している。

前節3.1.で観察した図-11の磁区構造をみてみよう。 ^{この場合の幾何学因子は1/cos Ψとなるので,}



図ー14 109*磁壁エネルギー Ø、と磁区エネル ギー Ø。の磁壁方位依存



が図-16である。 2 d = 0 のとき Ψ*= 0 からかなり 急速 に Ψ*は増加して 90 に漸近する。 X線トポグラフによ る実測結果は〇印で図示されている。

従来の理論では2d の値のいかんにかかわらず Ψ = 0 すなわち(110) 面であるが、ここで提案された考え



図-16 109*磁壁の安定方位 Ψ*と磁区の大き さ2dとの関係曲線, 〇印はX 線トポ グラフ観察よりえられた実測値

方によると、Ψ*≒63 になる。実測値 Ψ*≒40 は理論値よ り小さくなる傾向がある。磁区の大きさ2d が小さいと きは90 磁壁の場合(図-5)も理論と実験結果にはずれが みられた。この原因は結晶の弾性異方性に起因してい る?

3.3. 71^{*}磁壁の安定方位

71 磁壁は図-10に示すようにく100>を軸として回転 できる。その方位は2つの磁化ペクトルのつくる面 {1 10}と磁壁とのなす角 Ψ で表わす。その磁区構造の模 型と座標系を図-17に示す。この場合の援転位密度テン ソル α_n, は109 磁壁の場合と同様な取扱いによって、

$$(a_{hj}) = 1.4182\lambda_{111} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \Psi & 0 \\ \sin \Psi & 0 & -\cos \Psi \end{pmatrix}$$
$$\{\delta(X_1 + a) - \delta(X_1 - a)\}$$
(3)



図-17 71°磁壁による弾性歪の計算のための 磁区構造モデル



図-18 71 磁壁と等価な擬転位の連続分布



図ー19 71^{*}磁壁エネルギー Ø_wと磁区エ^{ネル} ギー Ø_aと磁璧方位依存

となる。上式を図-18にえがいている。 109 磁壁の擬転位分布モデルと比較すると、刃状成分 (a_{31})の符合のみ逆になっていて、他のらせん成分(a_{3n} , a_{3n})は同じであることがわかる。磁区エネルギーのは 従って、109 磁壁のそれと同じになり、式四で与えられ る。71 磁壁の o_w と o_d との比較を図-19に示す。 図-17の磁区構造の実効エネルギー o_{en} は、

ab



図ー20 71・磁壁の安定方位 W・と磁区の大きさ 2dとの関係曲線

で与えられる。上式から71⁻磁壁の安定方位 Ψ・と磁区の 大きさ2dとの関係を求めたものが図-20である。2d = 0のときΨ・≒50⁻から90⁻へ漸近する。いうまでもなく従 来の磁区構造論ではΨ・≒50⁻で2dの値の大きさにかか わらす一定となる。

§1.結 論

前報"において、磁壁の安定方位に関する従来の磁区 構造論には磁壁方位に依存する重要なエネルギー因子が 見落されていることを指摘し、結晶内の磁区構造を説明 できる考え方とその計算法を述べた。本論文において、 その基本的考え方を鉄90°磁壁、ニッケル109 および71 磁壁に適用して従来の理論との違いを具体的に明らかに した。この理論的結果を鉄ウィスカー、ニッケル板状結 晶のX線トポグラフ観察からえた実測結果と比較するこ とによって理論の健全性を実証した。

なおこの考え方は他の強磁性磁壁や電垂を有する強誘 電体の分域壁にも応用することができる。また擬転位分 布に磁壁を置換する方法は、磁化過程に格子欠陥の及ぼ ^{す影響を}議論する際にも有効である。

謝 辞

擬転位分布論について有益なご教示をいただきました 東工大総合理工研の森勉教授に感謝の意を表します。森 教授との議論がなかったならば、本報告はもとより、磁 区構造論に関して他に発表された研究も実を結ばなかっ たであろう。

図の仕上げはすべて物理教室城井英樹技官の手になる ものである。

容 考 文 献

1) L. Néel : Cahiers Phys. 25 (1944) 1.

2)近湖吉則;九州工業大学研究報告(工学) 第39号,(昭和54年), p. 213.

- 3) L. Spacek; Ann. Phys. 7 (1960) 217.
- 4) Y. Chikaura and S. Nagakura ; Jpn. J. Appl. Phys. 11 (1972) 158.
- 5) Y. Chikaura and S. Nagakura; Acta Cryst. A28 (1972) 235.

6) R. W. DeBlois and C. D. Graham, Jr.; J. Appl. Phys. 29 (1959) 931.

- 7) Y. Chikaura, H. Fukumori and S. Nagakura; Jpn. J. Appl. Phys. 11 (1972) 1582.
- 8) Y. Chikaura, M. Tomimatsu and S. Nagakura; J. Cryst. Growth 24/25 (1974) 334.
- 9) 森勉、近浦吉則; 日本金属学会1977年秋期講演会予稿集(広島)。